



لیگ  
پژوهشی  
فوتونیک  
و مهندسی

بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران  
۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۳، دانشگاه شهید بهشتی



## بهبود جذب نوری سلول خورشیدی لایه نازک سیلیکانی در اثر حساس سازی با آرایه ای از نانوذرات فلزی نقره

سید سامان کهنه پوشی<sup>\*</sup>، ابوالفضل چمن مطلق<sup>#</sup>

تهران، جهاد دانشگاهی تربیت مدرس، گروه تکنولوژی نانوذرات <sup>\*</sup>

[saman.device@yahoo.com](mailto:saman.device@yahoo.com) <sup>#</sup>استادیار دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

چکیده - در سلول‌های خورشیدی لایه نازک به منظور افزایش جذب، طراحی‌های مختلفی از جمله زبر کردن سطح سلول، استفاده از لایه‌های بازتابی در زیر سلول و حساس سازی با نانوذرات فلزی معروفی شده است. در این مقاله به منظور افزایش جذب، از نانوذرات فلزی روی سلول استفاده شده است. در اثر تشدید پلاسمونی محلی، و همچنین پراکنش نور ناشی از وجود نانوذرات و به تلهاندازی نور در داخل ساختار، طیف جذبی در بازه‌ای از طول موج در محدوده‌ای که با توجه به طیف تابشی استاندارد AM 1.5 شدت نور خورشید بیشتر است، ۲۰٪ بهبود می‌یابد. تاثیر فاصله نانوذرات از هم و اندازه آنها روی طیف جذبی بررسی شده است. از آنجایی که فاصله نانوذرات روی بازتاب و پراکنش نور به داخل ساختار تأثیرگذار است دیده می‌شود که به ازای فاصله خاصی می‌توان بیشترین افزایش جذب را حاصل کرد این فاصله برای نانوذرات با قطر ۴۰ و ۸۰ نانومتر به ترتیب ۴۰ و ۶۰ نانومتر می‌باشد.

کلید واژه - سلول خورشیدی لایه نازک، نانوذرات نقره، پلاسمون محلی، پراکنش نوری.

## Improvement of thin film silicon solar cell light absorption caused decorated with the array of metallic Ag nanoparticles

S. Kohnehpoushi\*, A. Chaman Motlagh<sup>#</sup>

\* Tehran, Nanotechnology Research Group, Academic Center for Education, Culture & Research (ACECR)  
on TMU, Tehran, Iran [saman.device@yahoo.com](mailto:saman.device@yahoo.com)

# Tehran, Emam Hossein university, Faculty of Electrical and Computer Engineering, [achaman@ihu.ac.ir](mailto:achaman@ihu.ac.ir)

Abstract- It is used different ways in order to increase the absorption of thin film solar cells. Roughen the surface, Use reflective layer under the cell and sensitization with metal nanoparticles such in. In this work, we use finite difference time domain (FDTD) method to analyze the plasmonic effect of Ag nanoparticles (NPs) on optical behaviour of thin film solar cell. Light absorption in the absorber layer is a key parameter to have an efficient cell. So in present work we utilize Ag NPs to enhance light absorption. By decorating Ag NPs on the cell, incident light will scatter and as well as if it is in the resonance frequency of electrons collective oscillations in the Ag NPs, then local surface plasmon resonances (LSPRs) will be excited that can increases field intensity around Ag NPs. The wavelengths of the sunlight with AM 1.5 intensity profile that intensity is higher, Absorption is increased by 20%. Reflection and scattering of light into the cell will be related to NPs distance. Seen that for a certain distance, absorption enhancement is higher. This distance for NP with diameters of 40 and 80 nm will be 40 and 60 nm respectively.

Keywords: Thin film solar cell, Ag Nanoparticles, Local plasmon, Light scattering.

## ۱- مقدمه

نقش ایفا کند. در مکانیزم اول نانو ذره‌های فلزی می‌تواند باعث پراکنش نور هنگام برخورد با سطح شده و در نتیجه مسیر بیشتری را در ناحیه جاذب طی کند که این باعث افزایش مقدار جذب خواهد شد. همچنین نانوذره‌های فلزی می‌تواند به عنوان آتن‌های زیر طول موج به صورت میدان نزدیک به نیمه‌هادی کوپل شود. در مکانیزم سوم برای حالتی که لایه فلزی چین دار در زیر لایه جاذب، وجود دارد، نور خورشید به پلاریتون پلاسمون سطحی تبدیل شده که می‌تواند در سطح فصل مشترک فلز و نیمه‌هادی تحریک شده و در لبه نیمه‌هادی هدایت شود. این امواج پلاسمونی می‌تواند در عرض سلول منتشر شده و جذب شود که منجر به تولید الکترون-حفره خواهد شد<sup>[۶]</sup>. پراکنش نور از یک نانوذره فلزی که در یک محیط همگن قرار دارد از تمامی جهات مثل هم است ولی وقتی این نانوذره در فصل مشترک بین محیط قرار می‌گیرد دیگر این قاعده صادق نبوده و پراکنش به سمت محیطی که ضریب شکست بالاتری دارد، بیشتر است. بنابراین نانو ذره را در سطح فصل مشترک بین هوا و دی-الکتریک قرار می‌دهیم که باعث می‌شود نور به سمت ناحیه جاذب پراکنده شود و در نتیجه مسیر بیشتری را در داخل سیلیکون بینند. البته مشاهدات تجربی ادعای بالا را نشان می‌دهد ولی تا به حال به صورت سیستماتیک روی آن کار نشده است<sup>[۱۲]</sup>. شکل و اندازه‌ی نانو ذره پارامتر مهمی در پراکنش نور به سمت لایه جاذب است. ذره‌های کوچکتر با ممان دو قطبی نزدیکتر به نیمه‌هادی مقدار بیشتری نور را به سمت نیمه‌هادی زیرین پراکنده می‌کند<sup>[۶]</sup>. برای تابع دی-الکتریک ذرات فلزی از مدل درود-لورنتز با دو پارامتر تنظیم استفاده شده است<sup>[۱۲]</sup>، که با نتایج تجربی جانسون و کریستی هم خوانی خوبی دارد<sup>[۱۴]</sup>. تاثیر اندازه ذرات در این مدل لحاظ شده است. می‌توان مدل را به صورت رابطه (۱) نوشت

$$(1) \quad \frac{f\omega_L^2}{\omega(\omega + i\gamma(a)) + \omega_L^2 + \omega^2 + i\beta\Gamma_L\omega} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + i\gamma(a))}$$

که  $\omega_L$  و  $\omega_p$  به ترتیب ضریب میرایی، بسامد میرایی و بسامد پلاسمما است که برای نقره به ترتیب  $10^{15}$ ،  $1/73 \times 10^{15}$ ،  $8 \times 10^{15}$ ،  $1/39 \times 10^{16}$  است.  $\alpha$  و  $\beta$  نیز که ضرایب تنظیم هستند به ترتیب  $1/3$  و  $0/2$  فرض شده است<sup>[۱۳]</sup>. ثابت میرایی پلاسمونی که به اندازه وابسته است به صورت رابطه (۲) است.

$$(2) \quad \gamma(a) = \gamma_b + AV_F/a$$

که  $\gamma_b$  ثابت میرایی برای توده نقره است برابر با  $3/19 \times 10^{-13}$   $V_F$ ، سرعت فرمی،  $a$  شعاع نانوذره،  $A$  ضریبی است که بسته به اینکه اطراف نانوذره را چه ماده‌های پوشانده باشد متفاوت است. برای ذرات داخل هوا این ضریب  $75/0$  است که برای ذرات داخل دی-الکتریک این ضریب بزرگتر خواهد بود.

با استفاده از تئوری رابلی قابلیت پلاریزه شدن ( $\alpha$ ) برای کره با ثابت دی-الکتریک نسبی  $\epsilon_r$  و حجم  $V$  به صورت زیر می‌باشد

$$(3) \quad \alpha = \epsilon_0 3V \frac{\epsilon_r + 1}{\epsilon_r + 2}$$

در نتیجه سطح مقطع جذبی و پراکنش به صورت زیر است:

$$(4) \quad C_{\text{scattering}} = \frac{k^4}{6\pi} |(\alpha/\epsilon_0)|^2 = \frac{k^4}{6\pi} (3V)^2 \frac{(\epsilon_r' - 1)^2 + \epsilon_r''^2}{(\epsilon_r' + 2)^2 + \epsilon_r''^2}$$

$$(5) \quad C_{\text{absorption}} = kV(\alpha/\epsilon_0) = 3kV \frac{3\epsilon_r''}{(\epsilon_r' + 2)^2 + \epsilon_r''^2}$$

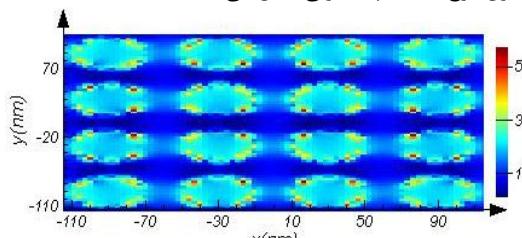
در سلول‌های خورشیدی کاهش هزینه به ازای تولید واحد انرژی یکی از مهمترین پارامترهایی است که باید مد نظر قرار گیرد. در جهت تحقق این هدف سلول‌های خورشیدی لایه نازک به عنوان نسل دوم سلول‌های خورشیدی معرفی شد<sup>[۲]</sup>. نیمه‌هادی‌های کریستالی یا بی نظم  $CdTe$ ,  $GaAs$ ,  $CuInSe_2$ ,  $Si$ ,  $a-Si$ ,  $CdTe$ ,  $CIGS$  ... از جمله موادی هستند که در این نوع سلول‌ها استفاده می‌شوند<sup>[۳]</sup>. بیشترین میزان بازده اندازه گیری شده برای سلول‌های  $nc-Si$ ،  $a-Si$ ،  $CdTe$ ،  $CIGS$  به ترتیب برابر با  $10/1$ ,  $9/5$ ,  $16/7$  و  $20/1$  درصد است<sup>[۴]</sup>. مشکل اصلی این نوع ساختارها، جذب پایین در لبه باند هدایت است، بنابراین به تله انداختن نور در این ساختارها برای افزایش ضریب جذب بسیار مهم است. در ساختارهای با ضخامت معمولی از روش زبر کردن سطح به صورت تکه‌های هرمی شکل که باعث افزایش سطح نورگیر و به تله انداختن نور می‌شود، میزان جذب نور را افزایش می‌دهند. ولی در ساختارهای لایه نازک از این روش نمی‌توان استفاده کرد<sup>[۵]</sup>. یکی از پیشنهادهایی که برای بهبود جذب در این ساختارها مطرح می‌شود استفاده از نانو ساختارهای فلزی است که می‌تواند نور را به تله بیاندازد و بازده سلول را بهبود دهد<sup>[۶]</sup>. بررسی‌های تجربی روی سلول‌های خورشیدی آلی<sup>[۷]</sup>، <sup>[۸]</sup> و غیرآلی<sup>[۹]</sup>، <sup>[۱۰]</sup> این افزایش جذب را در اثر حساس‌سازی توسعه نانوذرات فلزی نشان می‌دهد. بهبود جذب و افزایش بازده با اضافه کردن لایه بازتابی توسعه Haug طراحی و ساخته شده است<sup>[۱۱]</sup>. نانوذرات فلزی با تبدیل نور ورودی به میدان پلاسمونی می‌تواند در طیف موج های خاصی نور ورودی را تقویت نموده و باعث افزایش جذب در سلول شود. بعلاوه حساس‌سازی توسعه نانوذرات فلزی باعث پراکنش بیشتر نور به داخل ساختار شده و می‌تواند منجر به جذب بیشتر نور ورودی شود<sup>[۶]</sup>. در این مقاله طیف جذبی سلول خورشیدی سیلیکانی بررسی شده است. ضخامت لایه فعال  $240$  نانومتر لحاظ شده و از لایه ITO با ضخامت  $80$  نانومتر به عنوان کاند و از Al با ضخامت  $80$  نانومتر به عنوان آند استفاده شده است. آرایه‌ای از نانوذرات فلزی نقره به منظور حساس‌سازی سلول روی لایه ITO چیده شده و تاثیر آن روی جذب سلول روی طیف جذبی، شبیه سازی شده است. در نهایت دوره تناوب بهینه معرفی خواهد شد.

## ۲- تئوری و فیزیک

مکانیزم کار سلول‌های خورشیدی تولید الکترون-حفره در اثر تابش نور خورشید است. در سلول‌های خورشیدی نیمه‌هادی، نور به سلول تابیده شده و در ناحیه فعال، جذب می‌شود. در اثر جذب نور، زوج الکترون-حفره تولید شده و به ترتیب به سمت آند و کاتد حرکت می‌کنند. از آن جایی که ضخامت لایه جاذب کم است، درصدی از نور جذب شده و مابقی از سل عبور می‌کند. با حساس‌سازی توسعه نانوذرات روی سل، می‌توان نور را به تله انداخت و درصد بیشتری از نور را جذب کرد. ساختارهای پلاسمونی به سه طریق می‌تواند در به تله انداختن و جذب حداکثری نور در سلول‌های خورشیدی تک لایه

شکل ۲- طیف جذبی لایه سیلیکانی برای حالتی که با نانوذره حساس نشدۀ است و همچنین در حالت حساس شده با آرایه ای از نانوذرات نقره به قطر ۴۰ نانومتر و فاصله ۲۰ نانومتر.

همان‌گونه که در شکل ۲ دیده می‌شود، حساس سازی توسط نانوذرات فلزی منجر به افزایش جذب در بازه‌ای از طول موج شده است. این افزایش جذب به پراکنش نور به محیط جاذب در اثر وجود نانوذرات مربوط است. نور به جای اینکه مسیری مستقیم در طول سلول را طی کند و درانتها از سلول خارج شود، در اثر برخورد با نانوذرات، پراکنده شده و مسیر بیشتری را در سلول می‌ماند و در آن به تله می‌افتد. در نتیجه امکان جذب فوتون‌های بیشتر مهیا می‌شود. از آن جایی که نور در مسیر تابش قبل از اینکه به لایه جاذب برسد با نانوذرات مواجه می‌شود، مقداری از فوتون‌ها در فلز جذب می‌شوند و به لایه جاذب نمی‌رسند، از اینرو در مجاورت طول موج تشید پلاسمونی (۳۶۰ نانومتر) که نانوذرات بیشترین جذب را دارند، میزان جذب لایه جاذب کاهش پیدا کرده است. با توجه به طیف تابشی خورشید AM در طول موج هایی که شدت تابش نور خورشید بیشتر است، افزایش جذب ساختار تاثیر بیشتری نسبت به سایر طول موج‌های طیف دارد، بنابراین در مجموع نانوذرات پلاسمونی باعث افزایش جذب ساختار و نتیجتاً افزایش بازده سلول خواهند شد. شکل ۳ پروفایل شدت میدان الکتریکی آرایه نانوذرات را در طول موج تشید پلاسمونی نشان می‌دهد.



شکل ۳- پروفایل شدت میدان الکتریکی آرایه نانوذرات با قطر ۴۰ نانومتر و فاصله ۴۰ نانومتر در طول موج تشید پلاسمونی (۳۶۰ نانومتر).

همان‌گونه که در شکل ۳ دیده می‌شود، شدت میدان الکتریکی در اثر تحریک پلاسمون‌های محلی، در اطراف نانوذرات بیشتر است. این امواج پلاسمونی می‌تواند با ناحیه جاذب کوپل شده و باعث تولید الکترون-حفره بیشتری شود. فاصله نانوذرات از هم روی میزان پراکنش نور به داخل و همچنین میزان جذب سلول تاثیرگذار خواهد بود. در شکل ۴ دیده می‌شود که ساختار در حالت هایی که فاصله نانوذرات از هم متفاوت است، طیف جذبی رفتاری متفاوت نشان می‌دهد. دیده می‌شود هرچه فاصله ذرات از هم بیشتر باشد، میزان افت جذب در مجاورت طول موج تشید پلاسمونی کمتر خواهد بود، زیرا میزان جذب در نانوذرات کمتر بوده و در نتیجه میزان نور بیشتری می‌تواند به ناحیه جاذب برسد. ولی میزان پراکنش نور نیز در این حالت کمتر بوده و در نتیجه میزان افزایش جذب در بازه طیف جذبی کمتر است. بنابراین طراحی فاصله بهینه در این نوع ساختارها امری ضروری است. شکل ۴ طیف جذبی، لایه جاذب را برای سه فاصله ۲۰، ۴۰ و ۶۰ نانومتری نانوذرات نقره به اندازه ۴۰ نانومتر را نشان می‌دهد.

$$\mathbf{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (6)$$

با توجه به معادلات بالا، سطح مقطع جذبی و پراکنش دارای تشید پلاسمونی در فرکانس تقریبی  $E_{resonance}/h$  است. برای ذرات آزاد در خلاء، انرژی تشید پراکنش نقره ۳۴۷ الکترون-ولت و برای طلا ۲۶ الکترون-ولت محاسبه شده است. هنگامی که این ذرات در محیطی با قابلیت پلاریزه شدن قرار گیرند، فرکانس تشید به انرژی‌های پایین‌تر یا به سمت قرمز طیف مرئی انتقال می‌یابد.

برای محاسبه جذب از نرم افزار Lumerical FDTD Solution استفاده شده است. در این نرم افزار جذب بر واحد حجم با دیبورانس بردار Poynting محاسبه می‌شود

$$P_{abs} = -0.5 \operatorname{real}(\vec{\nabla} \cdot \vec{P}) \quad (7)$$

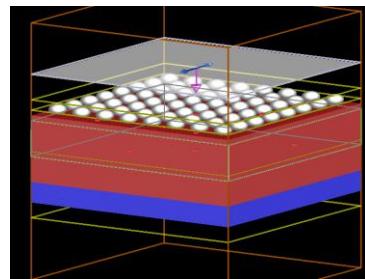
که در نهایت به صورت رابطه (۸) استخراج می‌شود.

$$P_{abs} = -0.5 \omega |E|^2 \operatorname{imag}(\epsilon) \quad (8)$$

که  $E$  میدان الکتریکی،  $\epsilon$  تابع دیالکتریک لایه جاذب و  $\omega$  بسامد نور ورودی است، در واقع توان جذبی تابعی از فرکانس خواهد بود.

### ۳- نتایج و بحث

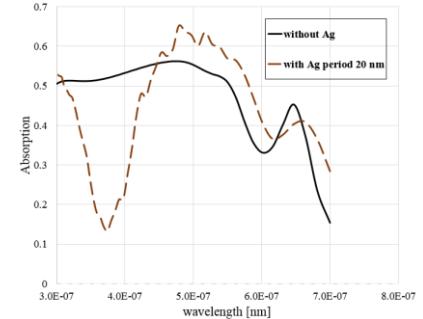
شکل ۱ شماتیک ساختاری سلول شبیه سازی شده را نشان می‌دهد.



شکل ۱- شماتیک ساختاری سلول برای حالتی که با نانوذرات نقره به قطر ۴۰ نانومتر حساس شده است.

لایه سیلیکانی بی نظم با ضخامت ۲۴۰ نانومتر به عنوان لایه جاذب استفاده شده است. از لایه‌های ITO و Al با ضخامت‌های ۲۰ نانومتر و ۸۰ نانومتر به ترتیب به عنوان کاتد و آند استفاده شده است. همان‌گونه که از شکل نشان داده شده است، آرایه‌ای از نانوذرات روى سل چیزه شده که به منظور بهبود پلاسمونی استفاده می‌شود. نور از بالا به ساختار تابیده شده است. ابعاد سل  $500 * 500$  nm فرض شده و شرایط مرزی در جهت Z و جهت‌های y,x به ترتیب PML و Periodic در نظر گرفته شده است. تابع دیالکتریک سیلیکان بی SOPRA N&K Database نظم از داده‌های استخراج شده است.

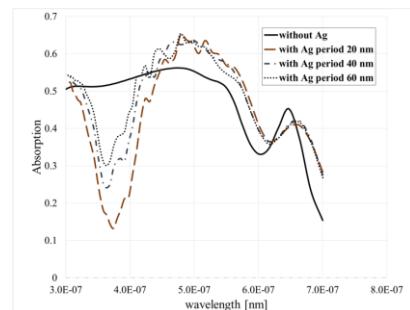
شکل ۲ طیف جذبی سلول را نشان می‌دهد.



فاصله نانوذرات روی بارتاب و پراکنش نور به داخل ساختار تاثیرگذار است. دیده می شود به ازای فاصله خاصی می توان بیشترین افزایش جذب را حاصل کرد این فاصله برای نانوذرات با قطر ۴۰ و ۸۰ نانومتر به ترتیب ۴۰ و ۶۰ نانومتر است.

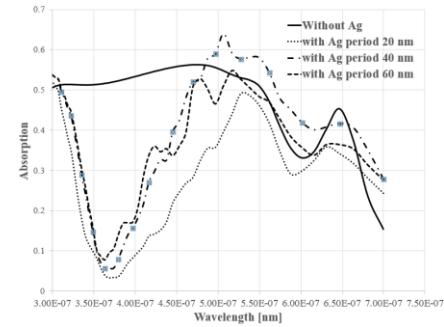
## ۵- مراجع

- [۱] J. Grandidier, D. M. Callahan, J. N. Munday, and H. A. Atwater, "Gallium arsenide solar cell absorption enhancement using whispering gallery modes of dielectric nanospheres," *Photovoltaics, IEEE Journal of*, vol. 2, pp. 123-128, 2012.
- [۲] S. Pillai and M. Green, "Plasmonics for photovoltaic applications," *Solar Energy Materials and Solar Cells*, vol. 94, pp. 1481-1486, 2010.
- [۳] M. Berginski, J. Hüpkens, M. Schulte, G. Schöpe, H. Stiebig, B. Rech, et al., "The effect of front ZnO: Al surface texture and optical transparency on efficient light trapping in silicon thin-film solar cells," *Journal of Applied Physics*, vol. 101, p. 074903, 2007.
- [۴] A. Luque and S. Hegedus, *Handbook of photovoltaic science and engineering*: John Wiley & Sons, 2011.
- [۵] S. Pillai, K. Catchpole, T. Trupke, and M. Green, "Surface plasmon enhanced silicon solar cells," *Journal of applied physics*, vol. 101, p. 093105, 2007.
- [۶] H. A. Atwater and A. Polman, "Plasmonics for improved photovoltaic devices," *Nature materials*, vol. 9, pp. ۲۰۱۰, ۲۱۳-۲۰۵.
- [۷] S.-S. Kim, S.-I. Na, J. Jo, D.-Y. Kim, and Y.-C. Nah, "Plasmon enhanced performance of organic solar cells using electrodeposited Ag nanoparticles," *Applied Physics Letters*, vol. 93, p. 073307, 2008.
- [۸] M. Westphalen, U. Kreibig, J. Rostalski, H. Lüth, and D. Meissner, "Metal cluster enhanced organic solar cells," *Solar Energy Materials and Solar Cells*, vol. 61, pp. 97-105, 2000.
- [۹] A. J. Morfa, K. L. Rowlen, T. H. Reilly III, M. J. Romero, and J. van de Lagemaat, "Plasmon-enhanced solar energy conversion in organic bulk heterojunction photovoltaics," *Applied Physics Letters*, vol. 92, p. 013504, 2008.
- [۱۰] S. Tong, C. Zhang, C. Jiang, G. Liu, Q. Ling, E. Kang, et al., "Improvement in the hole collection of polymer solar cells by utilizing gold nanoparticle buffer layer," *Chemical Physics Letters*, vol. 453, pp. 73-76, 2008.
- [۱۱] F.-J. Haug, T. Söderström, O. Cubero, V. Terrazzoni-Daudrix, and C. Ballif, "Influence of the ZnO buffer on the guided mode structure in Si/ZnO/Ag multilayers," *Journal of Applied Physics*, vol. 106, p. 044502, 2009.
- [۱۲] J. Mertz, "Radiative absorption, fluorescence, and scattering of a classical dipole near a lossless interface: a unified description," *JOSA B*, vol. 17, pp. 1906-1913, 2000.
- [۱۳] V. P. Drachev, U. K. Chettiar, A. V. Kildishev, H.-K. Yuan, W. Cai, and V. M. Shalaev, "The Ag dielectric function in plasmonic metamaterials," *Optics express*, vol. 16, pp. 1186-1195, 2008.
- [۱۴] P. B. Johnson and R.-W. Christy, "Optical constants of the noble metals," *Physical Review B*, vol. 6, p. 4370, 1972.



شکل ۴- طیف جذبی لایه سیلیکانی برای حالتی که با نانوذره حساس نشده است و همچنین در حالتی های حساس شده با آرایه ای از نانوذرات نقره به قطر ۴۰ نانومتر و در دوره تناوب های ۲۰، ۴۰ و ۶۰ نانومتر.

از آنجایی میزان قطیش پذیری نانوذرات به اندازه آن نیز وابسته است، با تغییر اندازه ذرات، انتظار می رود که رفتار نوری آن متفاوت بوده و به طبع طیف جذبی سلول متفاوت باشد. شکل ۵ طیف جذبی، لایه جاذب را برای سه فاصله ۲۰، ۴۰ و ۶۰ نانومتری نانوذرات نقره به اندازه ۸۰ نانومتر را نشان می دهد.



شکل ۵- طیف جذبی لایه سیلیکانی برای حالتی که با نانوذره حساس نشده است و همچنین در حالتی های حساس شده با آرایه ای از نانوذرات نقره به قطر ۸۰ نانومتر و در دوره تناوب های ۲۰، ۴۰ و ۶۰ نانومتر.

همان گونه که دیده می شود در این طراحی حساس سازی با نانوذرات فلزی نه تنها باعث افزایش جذب نخواهد شد بلکه منجر به کاهش جذب نیز خواهد شد. در حالت حساس سازس سلول با نانوذرات با قطر ۸۰ نانومتر و فاصله ۴۰ نانومتر، پراکنش های نوری به سمت داخل ساختار نبوده و بیشتر حالت انعکاسی دارد بنابراین جذب در ساختار کمتر خواهد شد. در حالتی که فاصله بیشتر می شود، نور بیشتر به داخل ساختار نفوذ کرده و بنابراین پروفایل جذب نسبت به طراحی های قبلی، وضعیت بهتری خواهد داشت.

## ۴- نتیجه گیری

در این مقاله شبیه سازی نوری سلول خورشیدی لایه نازک سیلیکانی انجام شد. به منظور بهبود طیف جذبی روی سلول استفاده شد. در اثر تشدید به صورت حساس شده روی سلول استفاده شد. در اثر تشدید پلاسمونی محلی، و همچنین پراکنش نور ناشی از وجود نانوذرات و به تله اندازی نور در داخل ساختار طیف جذبی در بازه ای از طول موج در محدوده ای که با توجه به طیف تابشی استاندارد AM ۱.۵ شدت نور خورشید بیشتر است، ۲۰٪ بهبود می یابد. تاثیر فاصله نانوذرات از هم و اندازه آنها روی طیف جذبی برسی شده است. از آنجایی که